ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР РАН

ДИНАМИКА НАГРЕВА И ИОНИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ИНТЕНСИВНЫМ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ

Костенко О.Ф., Андреев Н.Е.

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Научно-координационная сессия "Исследования неидеальной плазмы"

4-5 декабря 2007, ОИВТ РАН, Москва

Мотивация

- [1] Костенко О.Ф., Андреев Н.Е. Нагрев и ионизация металлических кластеров полем интенсивного фемтосекундного лазерного импульса // Физика плазмы. 2007. Т. 33. № 6. С. 556 – 562.
- [2] Kostenko O., Andreev N. Inverse bremsstrahlung heating of large metal clusters by intense femtosecond laser field // Interaction of Short Petawatt Laser Pulses with Plasma - Theory and Simulations. Laserlab Europe Workshop, Darmstadt, October 14 - 17, 2007.
- [3] Костенко О.Ф., Андреев Н.Е. Образование высокоэнергетических ионов при разлете нагретого и ионизованного фемтосекундным лазерным импульсом металлического кластера // Тезисы XXII Международной конференции «Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество», Эльбрус – 2007. С. 29.
- Кластер железа R = 25 нм, I₀ = 1.4×10¹⁸ Bт/см², T₁/2 = 100 фс, λ = 1.24 мкм
- $T_e = 3$ кэВ, Li- и Ве-подобные ионы железа, $E_{ion} = 4.8$ МэВ

Содержание

Учет эффектов, существенных на начальной стадии нагрева и ионизации металлического кластера:

- вырождение электронов
- неидеальность плазмы
- понижение энергии ионизации
- рекомбинация электронов
- модель диэлектрической проницаемости вырожденной плазмы

Нагрев кластера

Динамика температуры электронов *Т_е* определялась из закона сохранения энергии:

$$I(t)Q_a(T_e,Z) = \frac{dU_e}{dt} + \frac{dU_i}{dt},$$

где I(t) – интенсивность лазерного излучения.

 Сечение поглощения однородного кластера определяется из теории Ми:

$$Q_{a} = -\frac{2\pi}{k_{0}^{2}} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \left[\operatorname{Re}(a_{n}^{r}) + \operatorname{Re}(b_{n}^{r}) + |a_{n}^{r}|^{2} + |b_{n}^{r}|^{2} \right]$$

• Энергия электронов с учетом вырождения:

$$U_{e} = V \frac{\sqrt{2}}{\pi^{2}} T_{e}^{5/2} F_{3/2} \left(\frac{\mu}{T_{e}}\right)$$

Модель ионизации

Мощность ионизации:

$$\frac{dU_i}{dt} = VI(Z)\frac{dN_e}{dt},$$

где *I*(*Z*) – средний потенциал ионизации с учетом его понижения.

Динамика среднего заряда:

$$\frac{dZ}{dt} = \left(1 - \frac{Z}{Z_{eq}}K_{eq}\right)W$$

 Скорость ударной ионизации *W* определялась путем усреднения произведения скорости электронов и сечения Лотца по распределению Ферми-Дирака с учетом принципа Паули для образующихся электронов

Модель равновесной функции

 Средний равновесный заряд ионов Z_{eq}(T_e) вычислялся с помощью уравнения Саха для вырожденной плазмы:

$$\frac{N_{i-1}^{*}}{N_{i}^{*}} = \frac{g_{i-1}}{g_{i}} \exp\left(\frac{I_{i-1} + \mu}{T_{e}}\right) \equiv K_{eq}^{i}$$

- Равновесная концентрация ионов *N*^{*}_{i−1} кратности (*i* − 1) считалась равной нулю, если соответствующий потенциал ионизации *I*_{i−1} ≤ 0
- Равновесная функция $K_{eq}(Z)$ выбиралась в виде:

$$K_{eq}(Z) = \min\left\{1, \frac{g(Z)}{g(Z+1)} \exp\left(\frac{I(Z) + \mu}{T_e}\right)\right\}$$

Понижение энергии ионизации

• Модель гибридного экранирующего потенциала

$$\Phi(r) = \Phi_{is}(r)\theta(r_b - r) + \Phi_D(r)\theta(r - r_b)$$

• Параметр неидеальности на границе между потенциалами $r = r_b$:

$$\frac{Z_{eff}}{r_b T_{eff}} = 1,$$

где Z_{eff} - эффективный заряд ионного остова и $T_{eff} = (T_e^2 + T_{Fe}^2)^{1/2}$

• Понижение энергии ионизации $I_i = I_{0i} - \Delta I_i$: $\Delta I_i = \frac{3Z_{eff}(i)}{2k^2 r_0^3} [[(kr_0)^3 + 1]^{2/3} - 1],$

где r_0 – радиус атомной ячейки, $k^{-1} = r_D = T_{eff}^{1/2}/\omega_p$ - дебаевский радиус

M.S. Murillo, J.C. Weisheit // Physics Reports. 1998. V. 302. N 1. P. 1.

Модель диэлектрической проницаемости

 Линейная диэлектрическая проницаемость определялась из уравнения Больцмана с интегралом столкновений в приближении времени релаксации:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{4}{3\pi\omega} \int_{0}^{\infty} \frac{p^{4}dp}{\omega + iv_{e}(p)} \frac{\partial f_{0}}{\partial \varepsilon},$$

где функция распределения Ферми-Дирака

$$f_0(\varepsilon) = \frac{1}{1 + \exp[(\varepsilon - \mu)/T_e]}$$

• Химический потенциал связан с плотностью электронов

$$N_e = \frac{1}{4\pi^3} \int f_0(p) d^3 p$$

Модель частоты столкновений электронов

• Кулоновская частота столкновений электронов

$$\nu(p) = \frac{4\pi N_{ion} Z^2 L}{p^3}$$

ограничивалась условием

$$v_e(p) = \min\left\{\frac{p}{r_0}, \frac{p^2}{2\pi}, v(p)\right\}$$

(длина свободного пробега электрона должна быть больше радиуса атомной ячейки и длины волны электрона)

Использовался кулоновский логарифм с радиусом экранирования
r_b + *r_D*, ограниченный условием *L* ≥ 2

Y.T. Lee, R.M. More // Phys. Fluids. 1984. V. 27. N 5. P. 1273.

Результаты вычислений



Динамика температуры электронов 1- $T_{e'}$ среднего заряда ионов 2- Z и равновесного среднего заряда 3- $Z_{eq}(T_e)$ при пиковой интенсивности 10^{18} BT/см² (максимум импульса – при t = 0) 1'- T'_e и 2'- Z' соответствуют работе [1]



Результаты вычислений

2,0-



Зависимость от времени параметра неидеальности $\Gamma = Z/(r_0 T_{eff})$ Зависимость от времени отношения среднего потенциала ионизации к температуре электронов



Спасибо за внимание

Model analysis

When the cluster expands at the ion sound velosity, its characteristic inhomogeneity scale length *L* exceeds the skin depth but is less than the radius. In this case, we have *L*/*λ* ≈ 2×10⁻². Note that, for this value of the *L*/*λ* and for *ν*/*ω* > 1, the coefficient of absorption of *p*-polarized radiation by a plane metal target corresponds to that in the case of a target with a sharp boundary [H.M. Milchberg et al. // J. Opt. Soc. Am. B. V. 6, 1351 (1989)]